



先端加工ネットワーク 第1回産官学連携研究開発講演会 「SiC が拓くパワーデバイスの未来」開催のご案内

主催：(社)砥粒加工学会 先端加工ネットワーク

このたび、『先端加工ネットワーク (AMT-NET)』では、次世代パワーデバイス材料として実用化が進められている大口径 SiC について、素材からウェハまでの製造プロセスを対象として、最新の技術、課題、解決への取り組みなどをご紹介いただく講演会を企画しました。関係各位の多数のご参加をお待ちしています。

日 時：平成 24 年 11 月 15 日 (木) 13:00~20:00

開催場所：関西大学東京センター (東京駅八重洲北口サピアタワー9階)

アクセスマップ：<http://www.kansai-u.ac.jp/tokyo/map.html>

内 容：テーマ「SiC が拓くパワーデバイスの未来」



司 会 先端加工ネットワーク幹事 千葉大学 比田井洋史

13:00~13:10 開会挨拶

先端加工ネットワーク委員長 千葉大学 森田 昇

13:10~14:10 特別講演 「大口径 SiC ウェハの加工技術開発」

独立行政法人産業技術総合研究所先進パワーエレクトロニクス研究センター 加藤 智久 氏

14:10~14:55 講演① 「昇華法による大口径 SiC 単結晶成長技術」

新日本製鐵(株) 先端技術研究所 藤本 辰雄 氏

14:55~15:10 休憩

15:10~15:55 講演②：「SiC 単結晶スライス加工技術」

トヨーエイテック(株) 開発設計部 星山 豊宏 氏

15:55~16:40 講演③：「SiC ウェハ研削加工技術」

(株)ナガセインテグレーション テクニカルセンター 藤井 大 氏

16:40~17:25 講演④：「パワー半導体用 SiC エピタキシャルウェハ生産技術」

昭和電工(株) 研究開発本部 SiC パワーエレクトロニクスプロジェクト 佐藤 貴幸氏

17:25~17:30 閉会挨拶

先端加工ネットワーク副委員長 金沢工業大学 諏訪部 仁

18:00~20:00 拡大技術交流会 トラットリア パンパミラノ (サピアタワー3階)

定 員：100 名 (申込先着順により定員になり次第締切ります)

参 加 費：15,000 円 (講演資料含む)。拡大技術交流会参加費 3,000 円 (予定) は別途徴収致します。

出欠回答締切：平成 24 年 11 月 9 日 (金)

出欠回答返信先並びに問合先：千葉大学大学院工学研究科機械系コース (先端加工ネットワーク幹事) 松坂壮太

TEL：043-290-3225 FAX：043-290-3225 E-mail：matusaka@faculty.chiba-u.jp

FAX：043-290-3225 E-mail：matusaka@faculty.chiba-u.jp

千葉大学大学院工学研究科機械系コース 松坂 宛

「先端加工ネットワーク第1回産官学連携研究開発講演会」 参加申込書

氏 名				
勤務先・所属				
拡大技術交流会 (どちらかに○をつけて下さい)	参加します ・ 参加しません			
連絡先	住所			
	TEL		FAX	
	E-mail			